This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



Adams & Wilks

ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW 50 BROADWAY 31st FLOOR

NEW YORK, NEW YORK 10004

BRUCE L. ADAMS VAN C. WILKS.

RIGGS T. STEWART (1924-1993)

JOHN R. BENEFIEL. PAUL R. HOFFMAN TAKESHI NISHIDA

TELEPHONE (212) 809-3700

FRANCO S. DE LIGUORIO

FACSIMILE (212) 809-3704

• NOT ADMITTED IN NEW YORK • REGISTERED PATENT AGENT

February 20, 2004

COMMISSIONER FOR PATENTS Washington, DC 20231

Re: Patent Application of Shinichi TAKASUGI et al.

Serial No. 09/975,194

Filing Date: October 10, 2001

Examiner: Ha T. Nguyen
Docket No. S004-4420 (RCE)

Group Art Unit:

2812

SIR:

The above-identified application was filed claiming the right of priority based on the following foreign application(s).

Japanese Patent Appln. No. 2000-310322 filed October 11., 2000 Japanese Patent Appln. No. 2001-214054 2. **filed** July 13, 2001 Japanese Patent Appln. No. filed 4. Japanese Patent Appln. No. filed

5. Japanese Patent Appln. No. filed

6. Japanese Patent Appln. No. 7. Japanese Patent Appln. No. filed

8. Japanese Patent Appln. No. filed

9. Japanese Patent Appln. No. filed

10. Japanese Patent Appln. No. filed 11. Japanese Patent Appln. No. filed

Certified copy(s) are annexed hereto and it is requested that these document(s) be placed in the file and made of record. MAILING CERTIFICATE

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first-class mail in an envelope addressed to: COMMISSIONER OF PATENTS & TRADEMARKS, Washington, DC 20231, on the date indicated below.

Respectfully submitted,

ADAMS & WILKS Attorneys for Applicant(s)

DEBRA BUONINCONTRI

Name

FEBRUARY 20, 2003

Date

BLA: db Enclosures By: Bruce L. Adams Reg. No. 25,386

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年10月11日

出願番号

Application Number:

特願2000-310322

出 願 人
Applicant(s):

株式会社エスアイアイ・マイクロパーツ

2001年10月12日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





5

【書類名】 特許願

【整理番号】 00000659

【提出日】 平成12年10月11日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01G 9/155

H01G 9/016

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原45-1 株式会社エ

スアイアイ・マイクロパーツ内

【氏名】 高杉 信一

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原45-1 株式会社エ

スアイアイ・マイクロパーツ内

【氏名】 渡邊 俊二

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原45-1 株式会社エ

スアイアイ・マイクロパーツ内

【氏名】 菅野 佳実

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原45-1 株式会社エ

スアイアイ・マイクロパーツ内

【氏名】 小野寺 英晴

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原45-1 株式会社エ

スアイアイ・マイクロパーツ内

【氏名】 中村 芳文

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原45-1 株式会社エ

スアイアイ・マイクロパーツ内

特2000-310322

【氏名】

酒井 次夫

【特許出願人】

【識別番号】

595071852

【氏名又は名称】

株式会社エスアイアイ・マイクロパーツ

【代表者】

滝口 泰輔

【代理人】

【識別番号】

100096286

【弁理士】

【氏名又は名称】

林 敬之助

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

009999

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9503485

【プルーフの要否】

不要

5

【書類名】

明細書

【発明の名称】

リフローはんだ付け実装可能な電気二重層キャパシタおよ

びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 正極と負極と非水溶媒と、支持塩を含む電解液とセパレータ とガスケットからなる部材と、外部への接続端子を有するリフローはんだ付け実 装可能な電気二重層キャパシタの製造方法において、

前記部材をかしめ封口により、内部に保持し組み立てる工程と

前記電気二重層キャパシタを加熱する工程と

前記接続端子を溶接する工程とからなる電気二重層キャパシタの製造方法。

【請求項2】 前記加熱の最大到達温度が、180℃~300℃であることを特徴とする請求項1記載の電気二重層キャパシタの製造方法。

【請求項3】 前記加熱する工程における時間に対する温度のプロファイルと、リフローはんだ付け実装時の時間に対する温度のプロファイルとの差が、0~150℃の領域において時間、温度とも±50%以内である請求項1記載の電気二重層キャパシタの製造方法。

【請求項4】 前記加熱する工程における時間に対する温度のプロファイルと、リフローはんだ付け実装時の時間に対する温度のプロファイルとの差が、1 50~180℃の領域において時間、温度とも±20%以内である請求項1記載の電気二重層キャパシタの製造方法。

【請求項 5 】 前記加熱する工程における時間に対する温度のプロファイルと、リフローはんだ付け実装時の時間に対する温度のプロファイルとの差が、1 80℃以上の領域において時間、温度とも±10%以内である請求項1記載の電気二重層キャパシタの製造方法。

【請求項6】 正極と負極と非水溶媒、支持塩を含む電解液とセパレータ、 ガスケットからなる部材と、外部への接続端子を有するリフローはんだ付け実装 可能な電気二重層キャパシタにおいて、製造工程で一度加熱されていることを示 すしるしを有することを特徴とするリフローはんだ付け実装可能な電気二重層キャパシタ。 【請求項7】 正極と負極と非水溶媒と、支持塩を含む電解液とセパレータとガスケットからなる部材をかしめ封口により、電気二重層キャパシタの内部に保持し組み立てる工程と

前記電気二重層キャパシタを加熱する工程と

前記接続端子を前記電気二重層キャパシタに溶接する工程と、

回路基板上に前記電気二重層キャパシタを配置し、前記加熱の時間と温度のプロファイルを等しくしリフローハンダ付けを行うことを特徴とする電子装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、コイン型(ボタン型)電気二重層キャパシタのなかでリフローはんだ付け実装可能な電気二重層キャパシタおよびその製造方法に関するものである

[0002]

【従来の技術】

コイン型電気二重層キャパシタは、移動体通信機器のメモリーなどのバックア ップ用電源として、プリント基板に装着されて用いられることが多い。

[0003]

従来、プリント基板上へのハンダ付は、ハンダこてを用いて行なわれていたが、機器の小型化あるいは高機能化にともない、プリント基板の同一面積内に搭載される電子部品を多くする必要が生じハンダ付のためにハンダこてを挿入する隙間を確保することが困難となってきた。また、ハンダ付け作業もコストダウンのため自動化が求められていた。

[0004]

そこであらかじめプリント基板上のハンダ付を行なう部分にハンダクリーム等を塗布しておきその部分に部品を載置するか、あるいは、部品を載置後ハンダ小球をハンダ付部分に供給し、ハンダ付部分がハンダの融点以上、例えば、200~260℃となるように設定された高温雰囲気の炉内に部品を搭載したプリント

基板を通過させることにより、ハンダを溶融させてハンダ付を行なう方法が用いられている(以下リフローハンダ付という)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

コイン型(ボタン型)でリフローハンダ付け実装可能な電気二重層キャパシタは、製造工程でセル内に異物(水分等)が混入、または電解液の注入量が多いと、セルを製品基板に実装するリフローハンダ付けにおいて、膨らみ、漏液(電解液がセル外部に漏れること)、最悪の場合は破裂を起こす場合があった。この場合、セルだけの交換ではなく基板を汚染してしまうため、製品への損害は非常に大きい。さらに、リフローハンダ付け後や保存後急激にキャパシタ特性が劣化することがあった。

[0006]

これらを防止するには、製造ばらつきを極限まで抑えなくてはならず、膨大な 費用を要する。また、それにおいても、膨らみ、漏液または破裂を完全に防げる 保証はなかった。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記の様な課題を解決するため、リフローハンダ付け実装可能な電気二重層キャパシタの製造において、電気二重層キャパシタ組立後、リフローハンダ付け工程における時間に対する温度のプロファイルと近いプロファイルでキャパシタの熱処理を行った。その後、キャパシタ特性および外観検査を行い、品質に異常のないものについて製造番号と熱処理済みである印として"H"を印字し、端子を溶接した。

[0008]

この熱処理は、端子溶接後でも有効であるが、ハンダめっきを施した端子の場合は加熱時の容器への付着等を考慮しなければならない。

[0009]

そして、このように熱処理を行った電気二重層キャパシタを回路基板に配置し 、キャパシタ製造時の熱処理に等しい温度プロファイルでリフローハンダ付けを 行い、電子装置を製造する。

[0010]

【発明の実施の形態】

リフローハンダ付け実装可能な電気二重層キャパシタは、製造工程でセル内に 異物(水分等)が混入、または電解液の注入量が多いと、セルを製品基板に実装 するリフローハンダ付けにおいて、膨らみ、漏液(電解液がセル外部に漏れるこ と)、最悪の場合は破裂を起こす場合があった。セルがリフローハンダ付けにお いて膨らむと端子の構造にもよるが、たいていの場合片方の端子が、基板から浮 き上がってしまい導通がとれずキャパシタとして機能しなくなる。漏液により、 外部にでた電解液には、支持塩が含まれるため空気中の水分と共に基板の回路を 腐食させてしまう。また破裂においては、基板や他の電子部品を損傷してしまう 可能性があるため、キャパシタを搭載しようとする製品への損害は非常に大きい

[0011]

これらを防止するには、製造ばらつきを極限まで抑えなくてはならず。膨大な 費用を要する。例えば、電解液注入の精度を上げるため、高価な電解液注入機を 導入する必要がある。しかし、それにおいても、膨らみ、漏液または破裂を完全 に防げる保証はなかった。

[0012]

また、リフローハンダ付け実装可能な電気二重層キャパシタは、リフローハンダ付け後のキャパシタ性能を保証しなければならない。製造のばらつきにより、セル内に異物(水分等)が混入する場合がある。常温におけるキャパシタ特性はほとんど変化がないが、リフローハンダ付け後や保存後急激にキャパシタ特性が劣化することがある。また、電解液の量が少ないとリフローハンダ付け後キャパシタ特性が予想以上に低下することがある。

[0013]

この様な課題を解決するために、実際のリフローハンダ付けに近い条件で一度 熱処理を行った。この熱処理に外観検査やキャパシタ特性(内部抵抗、セル高さ) を調べることにより、製造工程においての異物の混入や電解液の多いキャパシ タを取り除くことができる。一度熱処理を施したキャパシタは、その後のリフローハンダ付けで破裂することはない。また、キャパシタ特性もリフローハンダ付け後に大きく変化することはなくなった。

[0014]

熱処理工程における時間に対する温度のプロファイルは、実際のリフローハンダ付け工程における時間に対する温度のプロファイルにできるだけ近いことが望ましい。リフローハンダ付けでのキャパシタの破裂をほぼ皆無にしたければ、リフローハンダ付けより、高い温度で、しかも長い時間の熱処理を施せばよい。

[0015]

熱処理回数は1回以上が好ましい。回数が多ければ、破裂に対する安全性は増 すが、キャパシタ性能が熱により劣化してくるので注意が必要である。

[0016]

図2に一般的なリフローハンダ付け工程における時間に対する温度のプロファイルを示した。温度はセル表面の温度を示している。熱処理工程における時間に対する温度のプロファイルはこのプロファイルにできるだけ近いことが望ましい。前記加熱する工程における時間に対する温度のプロファイルと、リフローはんだ付け実装時の時間に対する温度のプロファイルとの差は、温度の低い部分ではある程度大きくても良いが、ピーク温度の付近の高い温度の部分では小さくする必要がある。これは熱処理工程において最高到達温度の影響が最も大きいためである。最高到達温度が低ければ、異常なキャパシタを十分に選別できないし、温度が高ければ、キャパシタにダメージを与えることになるためである。実験の結果、プロファイルの差が、0~150℃の領域において時間、温度とも±50%以内、150~180℃の領域において時間、温度とも±20%以内、180℃以上の領域において時間、温度とも±10%以内であれば、十分な効果があることがわかった。

[0017]

熱処理を行い、外観検査やキャパシタ特性(内部抵抗、セル高さ)を調べ選別 したキャパシタに何らかのしるしを付けることは、工程での熱処理有無の確認、 および客先でのチェックにおいて非常に有効である。例えば、インクを用いて印 字したり、レーザーマーカーによりしるしを付けることができる。

[0018]

この熱処理は、端子溶接後でも有効であるが、ハンダめっきを施した端子の場合は加熱時の容器への付着等を考慮しなければならない。また溶接後の熱処理で、不良と判断されたキャパシタは、キャパシタのみで不良と判断されたキャパシタに比べ部品と溶接工程が多いため、コスト的に無駄が多くなってしまう。

[0019]

[0020]

電気二重層キャパシタに使用する分極性電極は、おが屑、椰子殻、ピッチなどを賦活処理して得られる粉末状活性炭を、適当なバインダーと一緒にプレス成形または圧延ロールして用いることができる。また、フェノール系、レーヨン系、アクリル系、ピッチ系などの繊維を、不融化及び炭化賦活処理して活性炭または活性炭素繊維とし、これをフェルト状、繊維状、紙状または焼結体状にしても用いてもよい。また、ポリアニリン(PAN)やポリアセンなども利用できる。活性炭粉末と導電材としてのカーボンブラックと結着材としてのポリ4 弗化エチレンとを所定量の割合で混合した後、成形したものが望ましい。

[0021]

電解質には、特に限定されることなく従来の電気二重層キャパシタや非水二次電池に用いられている非水溶媒が用いられる。上記非水溶媒には、環状エステル類、鎖状エステル類、環状エーテル類、鎖状エーテル類等が用いられ、具体的には、プロピレンカーボネート(PC)、エチレンカーボネート(EC)、ブチレンカーボネート(BC)、ビニレンカーボネート、ジメチルカーボネート(DMC)、ジエチルカーボネート(DEC)、 γ -ブチロラクトン(γ BL)、2メチル- γ -ブチロラクトン、アセチル- γ -ブチロラクトン、 γ -バレロラクトン、1、2ージメトキシエタン(DME)、1、2-エトキシエタン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジアルキルエーテル、トリエチレングリコールジアルキルエーテル、テトラエチレン

グリコールジアルキルエーテル、ジプロピルカーボネート、メチルエチルカーボネート、メチルブチルカーボネート、メチルプロピルカーボネート、エチルブチルカーボネート、エチルプロピルカーボネート、ブチルプロピルカーボネート、プロピオン酸アルキルエステル、マロン酸ジアルキルエステル、酢酸アルキルエステル、テトラヒドロフラン(THF)、アルキルテトラヒドロフラン、ジアルキルアルキルテトラヒドロフラン、アルコキシテトラヒドロフラン、ジアルコキシテトラヒドロフラン、1,3-ジオキソラン、アルキル-1,3-ジオキソラン、1,4-ジオキソラン、ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、ジオキソラン、アセトニトリル、ニトロメタン、蟻酸メチル、酢酸メチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸ステル、リン酸トリエステル、無水マレイン酸、スルホラン、3ーメチルスルホランなどの非水溶媒およびこれらの誘導体や混合物などが好ましく用いられる。

[0022]

リフローハンダ付けように本発明の電気二重層キャパシタを用いる場合は、電解液としては常圧での沸点が200℃以上の非水溶媒が安定であるので、プロピレンカーボネート(PC)、エチレンカーボネート(EC)、γーブチロラクトン(γBL)選ばれる単独または複合物で用いることが良好であった。

[0023]

これら非水溶媒中に存在する主な不純物としては、水分と、有機過酸化物(例えばグリコール類、アルコール類、カルボン酸類)などが挙げられる。前記各不純物は、電極の表面に絶縁性の被膜を形成し、電極の界面抵抗を増大させるものと考えられる。したがって、サイクル寿命や容量の低下に影響を与える恐れがある。また高温(60℃以上)貯蔵時の自己放電も増大する恐れがある。このようなことから、非水溶媒を含む電解質においては前記不純物はできるだけ低減されることが好ましい。具体的には、水分は50ppm以下、有機過酸化物は1000ppm以下であることが好ましい。

[0024]

支持塩としては(C2H5) 4PBF4、(C3H7) 4PBF4、(CH3

)(C2H5)3NBF4、(C2H5)4NBF4、(C2H5)4PPF6、(C2H5)4PCF3SO4、(C2H5)4NPF6、過塩素酸リチウム(LiClO4)、六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)、ホウフッ化リチウム(LiBF4)、六フッ化砒素リチウム(LiAsF6)、トリフルオロメタスルホン酸リチウム(LiCF3SO3)、ビストリフルオロメチルスルホニルイミドリチウム[LiN(CF3SO2)2]、チオシアン塩、アルミニウムフッ化塩などのリチウム塩などの1種以上の塩を用いることができる。これら中で、アンモニウム塩を用いたものが、サイクル特性、保存特性の面で良好であった

[0025]

また、ポリエチレンオキサイド誘導体か該誘導体を含むポリマー、ポリプロピレンオキサイド誘導体か該誘導体を含むポリマー、リン酸エステルポリマー等も上記支持塩と併用し用いることもできる。

[0026]

ポリマーと支持塩を混合して用いる固体電解質は、溶媒除去法などで作製される。ポリマーと支持塩をアセトニトリルや1、2ージメトキシエタンなどに溶解した後、本発明のセパレーターに塗布し乾燥する方法である。また、PEOと支持塩を溶解した溶液にポリピロールを分散させ、溶媒を除去する方法もある。メタクリル酸エステルを骨格に持つ複合体(POE-PMMA)では、モノマーと支持塩の混合物を加熱や光照射により重合させることもできる。

[0027]

セパレーターとしては、大きなイオン透過度を持ち、所定の機械的強度を持ち 絶縁性の膜が用いられる。リフローハンダ付け用としては、ガラス繊維が最も安 定して用いることができるが、熱変形温度が230℃以上のポリフェニレンサル ファイド、ポリエチレンテレフタレート、ポリアミド、ポリイミドなどの樹脂を 用いることもできる。セパレーターの孔径は、一般にキャパシタ用として用いら れる範囲が用いられる。例えば、0.01~10μmが用いられる。セパレータ ーの厚みは、一般にキャパシタ用の範囲で用いられる例えば、5~300μmが 用いられる。

[0028]

ガスケットも通常ポリプロピレン等が用いられるがリフローハンダ付けを行う 場合は、熱変形温度が230℃以上の樹脂がポリフェニレンサルファイド、ポリ エチレンテレフタレート、ポリアミド、液晶ポリマー(LCP)、テトラフルオ ロエチレンーパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合樹脂(PFA)、ポリ エーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)、ポリエーテルニトリル樹脂(PEN)、がリフロー温度での破裂等がなく、しかもリフロー後の保存においてもガス ケットの変形による漏液などの問題がなかった。

[0029]

この他、ポリエーテルケトン樹脂(PEK)、ポリアリレート樹脂、ポリブ チレンテレフタレート樹脂、ポリシクロヘキサンジメチレンテレフタレート樹脂 、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリアミノビスマレイミド樹脂、ポリエーテルイ ミド樹脂、フッ素樹脂が使用できる。また、この材料に10重量%程度以下の添加量でガラス繊維、マイカウイスカー、セラミック微粉末等を添加したものであ っても、本実験と同様の効果を発揮することが実験によって判明している。

[0030]

ガスケットの製造方法としては、射出成型法、熱圧縮法等がある。

[0031]

射出成形法はガスケットの成形方法としては最も一般的である。ただし、コストダウン等により成形精度を犠牲にする場合は、液体シール剤を用い気密を補う ことが必須となる。

[0032]

熱圧縮法は、成形品のガスケット形状よりも厚みの厚い板材を素材成形品として融点以下で熱圧縮成形を行い最終成型品を得る方法である。

一般に素材成形品から融点以下の温度で熱圧縮成形で成形された熱可塑性樹脂の成形品に温度を加えると、元の素材成形品の形状に戻ろうとする性質がある。これにより、本来であれば外缶及び内缶(金属)とガスケット(樹脂)の間に隙間ができるあるいは缶とガスケットの間に封止に十分な応力が得られなくなるはずの電気二重層キャパシタにこのガスケットを用いることで、熱処理(リフローは

んだ付け等)によるガスケットの膨張で外缶及び缶(金属)とガスケット(樹脂)の間に隙間ができずあるいは缶とガスケットの間に封止に充分な応力が得られるようになる。

[0033]

また、経時的に元の素材成形品の形状に戻ろうとする性質があり、リフローは んだ付け以外のキャパシタにおいても効果がある。

[0034]

特にテトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合樹脂(PFA)を用いたガスケットにおいては、射出成形で作製したものより、シート状の材料を加熱加圧して作製するコンプレッション成形のものの方が封口性が良好であった。これは、PFAがゴム弾性を有していることと、射出成型品はリフロー温度で収縮するのに対し熱圧縮成形品はリフロー温度で成形前のシートの厚さに戻ろうとするため、封口部分の内圧が上昇しより一層の封口気密が達成できる。

[0035]

コイン、ボタン型キャパシタの場合ガスケットと正・負極缶の間にアスファルトピッチ、ブチルゴム、フッ素系オイル、クロロスルホン化ポリエチレン、エポキシ樹脂等の1種または混合物の液体シール剤が用いられる。液体シール剤が透明の場合は着色して、塗布の有無を明確にすることも行われる。シール剤の塗布法としては、ガスケットへのシール剤の注入、正・負極缶への塗布、ガスケットのシール剤溶液へのディッピング等がある。

[0036]

本発明のキャパシタは除湿雰囲気または、不活性ガス雰囲気で組み立てることが望ましい。また、組み立てる部品も事前に乾燥するとこが好ましい。ペレットやシートおよびその他の部品の乾燥又は脱水方法としては、一般に採用されている方法を利用することができる。特に、熱風、真空、赤外線、遠赤外線、電子線及び低湿風を単独あるいは組み合わせて用いることが好ましい。温度は80~350℃の範囲が好ましく、特に100~250℃の範囲が好ましい。含水量は、セル全体で2000ppm以下が好ましく、分極性電極や電解質ではそれぞれ5

0 p p m以下にすることが充放電サイクル性向上の点で好ましい。

[003.7]

以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。

[0038]

【実施例】

(実施例1)

図1はコイン型電気二重層キャパシタの断面図である。図中、要素部品は、正極缶101、導電接着材102、分極性電極の正極成形体103、負極缶104、導電接着材105、分極性電極の負極成形体106、電解液109、セパレータ108、ガスケット107を主な構成要素としている。ガスケット107は、PPSを用いている。分極性電極は、活性炭80重量%、導電材のカーボンブラック10重量%、結着材の四フッ化エチレン10重量%を混合、圧延し、シートとした。正極の成形体103は、厚み0.5mmt、直径2.0mmφであり、負極の成形体106は、厚み0.5mmt,直径2.0mmφとした。正極および負極の成形体の103および106は、各々正極缶101および負極缶104と、導電性カーボン接着材の102および105を用いて接着した。成形体と缶が接着した後の正極および負極の各ユニットは、150℃の温度で、10-2torr以下の真空下で熱処理した。

[0039]

電気二重層キャパシタの作製は、露点が-40℃以下のドライルーム中で行った。負極缶104にガスケット107を挿入し、ガラス繊維製セパレータ108を負極の電極上に載置した後、有機電解液109を注入した後、正極缶101をかしめて封口した。有機電解液は、沸点が約240℃のプロピレンカーボネート(略称PC)溶媒に、テトラアルキルアンモニウムの4弗化硼酸塩の溶質を溶解したものを使用した。

[0040]

次に、温風加熱方式のリフロー炉を用いて3000個のキャパシタを加熱した。 。加熱プロファイルは、図2と同様とした。

[0041]

その結果破裂したキャパシタが0個、漏液したキャパシタが259個であった。更にキャパシタ特性を測定したところ、高さの上昇したキャパシタが12個、内部抵抗が1割以上上昇したキャパシタ126個発見された。

[0042]

特性に異常のなかったキャパシタについて、正極端子111と負極端子112 をレーザー溶接し、基板に図2と同様のプロファイルでリフローハンダ付けを行った。

[0043]

基板にハンダ付けを行ったキャパシタについて、外観検査とキャパシタ特性検査を行ったが異常を示したキャパシタは1個もなかった。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明のリフローはんだ付け実装可能な電気二重層キャパシタの断面図

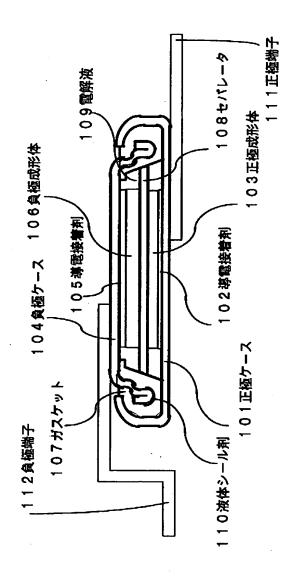
【図2】

リフローハンダ付け工程における時間に対する温度のプロファイル

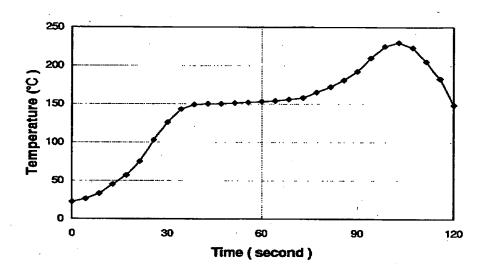
【符号の説明】

- 101 正極ケース
- 102 導電接着剤
- 103 正極成形体
- 104 負極ケース
- 105 導電接着剤
- 106 負極成形体
- 107 ガスケット
- 108 セパレータ
- 109 電解液
- 110 液体シール剤
- 111 正極端子
- 112 負極端子

【書類名】図面【図1】



【図2】



特2000-310322

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 リフローハンダ付け可能な電気二重層キャパシタの提供。

【解決手段】 電気二重層キャパシタ組立後、リフローハンダ付け工程における時間に対する温度のプロファイルと近いプロファイルでキャパシタの熱処理を行い、その後、端子を溶接した。

【選択図】 図1

特2000-310322

出願人履歴情報

識別番号

[59.5071852]

1. 変更年月日 1

1999年 2月26日

[変更理由]

住所変更

住 所

宮城県仙台市青葉区上愛子字松原45-1

氏 名

株式会社エスアイアイ・マイクロパーツ